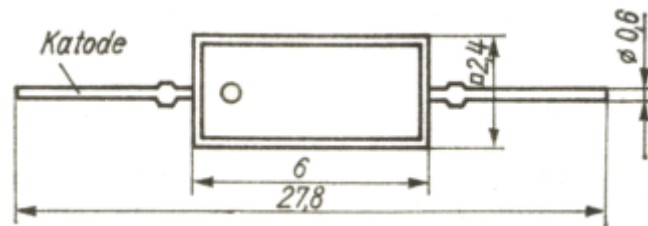


RFT SA403

Silizium- Epitaxie- Diode im Plastikgehäuse für Anwendungen in der Digital-, NF-, und HF- Technik, vorzugsweise als mittelschneller Schalter in Logikschaltungen



Grenzwerte

gültig bis ϑ_{jmax}

Sperrgleichspannung	U_R	=	25V
Durchlaßgleichstrom	I_F	=	30mA
Scheitelspannung	U_{RRM}	=	30V
Scheiteldurchlaßstrom	I_{FRM}	=	60mA
Sperrschichttemperatur	ϑ_j	=	+125°C
Lagerungstemperaturbereich	ϑ_{stg}	=	-55 ... +125°C
Gesamtverlustleistung	P_{tot}	=	100mW

statische Kennwerte

Durchlaßspannung bei $I_F \leq 0,1mA$, $\vartheta_a = 25^\circ$	U_F	\geq	0,5V
Durchlaßspannung bei $I_F = 3mA$, $\vartheta_a = 25^\circ C$	U_F	\leq	0,81V
Sperrstrom bei $U_R = 25V$, $\vartheta_a = 25^\circ C$	I_R	\leq	40nA
Sperrstrom bei $U_R = 25V$, $\vartheta_a = 40^\circ C$	I_R	=	300nA

Dynamische Kennwerte

Nullpunktkapazität $U_R = 0V$, $f = 0,5MHz$	C_o	=	5,0 ($\leq 8,5$) pF
Sperrverzögerungszeit beim Schalten von $I_F = 10mA$ auf $U_R=6V$ gemessen bei $I_R = 1mA$, $R_L = 50 \text{ Ohm}$	t_{rr}	=	50 (≤ 65) nS

Quelle: Aktive elektronische Bauelemente – 1985 & 1989